

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของฟิล์มนางชิงค์ออกไซด์ (ด้วยวิธีการสปัตเตอร์ริง)
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์	15 หน่วย
โดย	นาย อนุชา วัฒนาภา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ ดำรงรัตน์ คร.นันทน์ ดาวรังสูร
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีวัสดุ
ปีการศึกษา	2544

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทางแสง และ สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มนางชิงค์ออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการผลิตฟิล์มนางชิงค์ด้วยเทคนิค ดี. ซี. สปัตเตอร์ริง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทั้งกำลังไฟฟ้าและเวลาในการเคลือบฟิล์ม โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ ความหนา อัตราการเคลือบ โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางแสง และ สมบัติทางไฟฟ้า

ในการทดลองได้ทำการสปัตเตอร์ริงชิงค์ฟิล์มลงบนกระดาษไอล์ (coming 2948) แผ่นเป้าโลหะชิงค์ บริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หลังจากนั้นนำฟิล์มที่ได้ไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 300 องศา เชลเซียส ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนไหลด้าน ทำการวัดสมบัติทางแสงด้วยเครื่องไฟโกลสเปกโตรมิเตอร์ของชามาสชู รุ่น UV-2100 โครงสร้างฟิล์มตรวจสอบโดยเครื่อง XRD รุ่น Phillips 1730/10 ตรวจสอบโครงสร้างที่ผ่านผิวด้วยเครื่อง SEM รุ่น Jeol JSM-6301F

ผลจากการศึกษาพบว่า ชิงค์ออกไซด์ฟิล์ม จะมีลักษณะใสสีเหลืองอ่อน ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยการส่องผ่านแสงช่วงความองเห็นมากกว่า 88 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยการส่องผ่านแสงช่วงอินฟราเรดมากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ ผลการวัดสมบัติการส่องผ่านแสงพบว่าเส้นกราฟมีการเปลี่ยนอย่างฉับพลันอยู่สองช่วงคือที่ความยาวคลื่น 950 และ 375 นาโนเมตรตามลำดับ ผลดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่า ค่าความถี่พลาสมาระหว่างชิงค์เท่ากับ 950 นาโนเมตร และแอบซ้อนชั้น外ของชิงค์ออกไซด์เท่ากับ 375 นาโนเมตร เนื่องจากช่องว่างพลังงานของชิงค์ออกไซด์มีค่าเท่ากับ 3.31 อิเลคตรอนโวลท์ ชิงค์ออกไซด์ให้ค่าเฉลี่ยในการส่องผ่านแสงในช่วงความองเห็นต่ำกว่าในช่วงคลื่นอินฟราเรดเป็นผลให้ดังนี้

๓

ผลกระทบต่อความร้อนของพิล์มน้ำค่าต่ำกว่า 1 การผลิตพิล์มน้ำซึ่งคือการใช้เครื่องจักรสปีดเตอร์ริงซึ่งพิล์มน้ำแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิสูงไม่เหมาะสมกับการผลิตผลกระทบต่อความร้อน

คำสำคัญ (Keywords) : ดี ชี สปีดเตอร์ริง / ซึ่งคือการใช้พิล์มน้ำ / สมบัติทางไฟฟ้า / สมบัติทางแสง / ผลกระทบต่อความร้อน